

## SF10KC60M

600V 10A

## 特長

- 高耐圧
- ソフトリカバリー
- 低VF

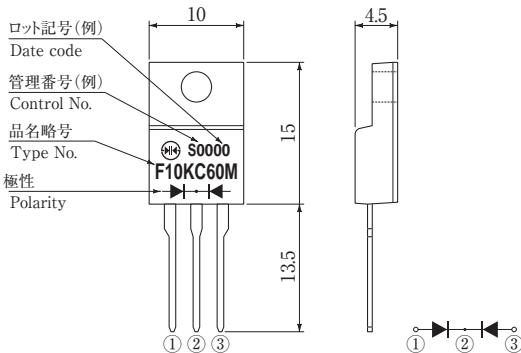
## Feature

- High Voltage
- Soft Recovery
- Low VF

## ■外観図 OUTLINE

Package : FTO-220AG

Unit:mm



外形図については新電元Webサイトをご参照下さい。捺印表示については捺印仕様をご確認下さい。

For details of the outline dimensions, refer to our web site. As for the marking, refer to the specification "Marking, Terminal Connection".

## ■定格表 RATINGS

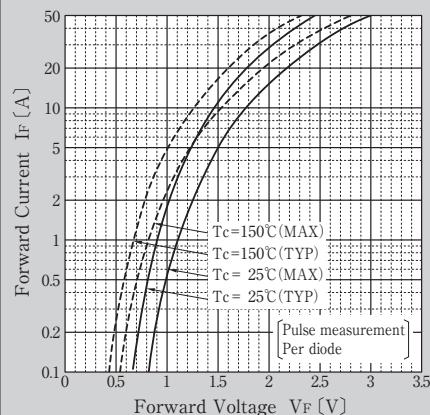
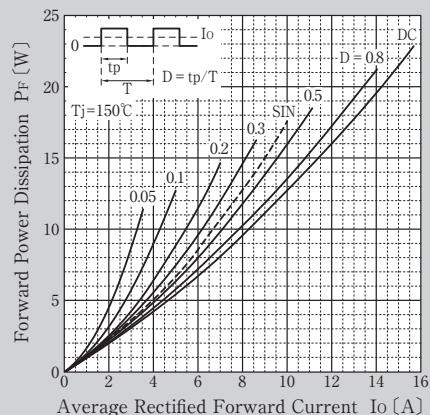
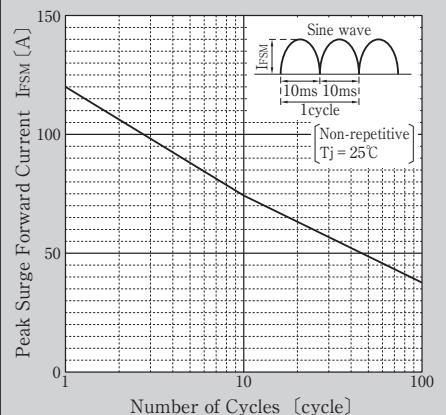
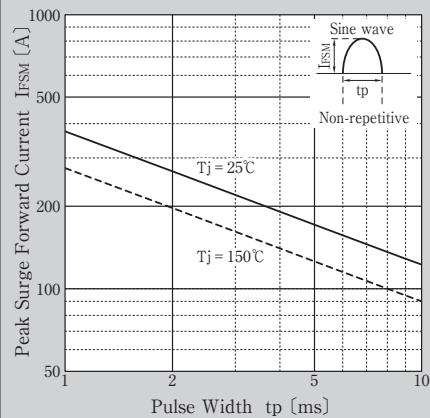
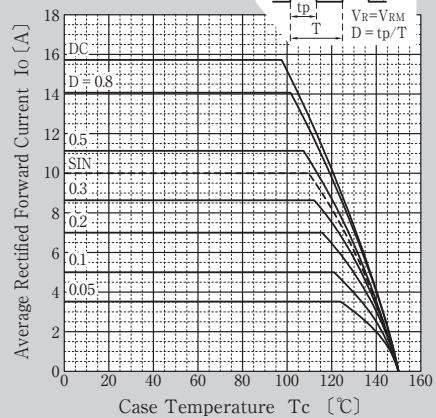
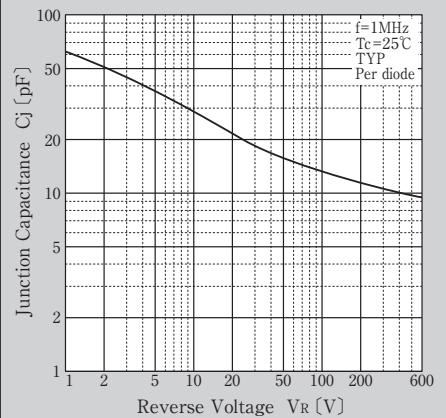
## ●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 Tc = 25°C)

項目 Item	記号 Symbol	条件 Conditions	規格値 Ratings	単位 Unit
保存温度 Storage Temperature	Tstg		-55~150	°C
接合部温度 Operation Junction Temperature	Tj		150	°C
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	V <sub>RM</sub>		600	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	I <sub>O</sub>	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, 1素子当りの出力電流平均値 I <sub>O</sub> /2, T <sub>c</sub> = 109°C 50Hz sine wave, Resistance load, Rating for each diode I <sub>O</sub> /2, T <sub>c</sub> = 109°C	10	A
せん頭サーボ順電流 Peak Surge Forward Current	I <sub>FSM</sub>	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> = 25°C 50Hz sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> = 25°C	120	A
	I <sub>FSM1</sub>	tp = 1ms 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, T <sub>j</sub> = 25°C tp = 1ms Sine wave, Non-repetitive 1 cycle peak value, T <sub>j</sub> = 25°C	379	
絶縁耐圧 Dielectric Strength	V <sub>dis</sub>	一括端子・ケース間, AC 1分間印加 Terminals to case, AC 1 minute	2.0	kV
締め付けトルク Mounting Torque	T <sub>OR</sub>	(推奨値: 0.3N·m) (Recommended torque: 0.3N·m)	0.5	N·m

## ●電気的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 Tc = 25°C)

順電圧 Forward Voltage	V <sub>F</sub>	I <sub>F</sub> = 0.5A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	TYP 0.81	V
		I <sub>F</sub> = 5.0A, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 1.50 TYP 1.23	
逆電流 Reverse Current	I <sub>R</sub>	V <sub>R</sub> = 600V, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Per diode	MAX 10	μA
逆回復時間 Reverse Recovery Time	trr	I <sub>F</sub> = 0.5A, I <sub>R</sub> = 1.0A, 0.25 I <sub>R</sub> 1素子当りの規格値 Per diode	MAX 85	ns
		I <sub>F</sub> = 1.0A, V <sub>R</sub> = 30V, di/dt = -50A/μs, 0.25 I <sub>R</sub> 1素子当りの規格値 Per diode	MAX 68	
		I <sub>F</sub> = 1.0A, V <sub>R</sub> = 420V, di/dt = -50A/μs, 0.25 I <sub>R</sub> 1素子当りの規格値 Per diode	MAX 78	
接合容量 Junction Capacitance	C <sub>J</sub>	f = 1MHz, V <sub>R</sub> = 10V 1素子当りの規格値 Per diode	TYP 28	pF
熱抵抗 Thermal Resistance	θ <sub>jc</sub>	接合部・ケース間 Junction to case	MAX 2.3	°C/W

## ■特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

順方向特性  
Forward Voltage順電力損失曲線  
Forward Power Dissipationせん頭サージ順電流耐量  
Peak Surge Forward Current Capabilityせん頭サージ順電流耐量  
Peak Surge Forward Current Capabilityディレーティングカーブ  $T_c$ - $I_o$   
Derating Curve  $T_c$ - $I_o$ 接合容量  
Junction Capacitance

\* Sine waveは50Hzで測定しています。  
\* 50Hz sine wave is used for measurements.